ホ　デジタルベースバンド信号をベクトル変調する機能を有するもので、ベクトル変調帯域幅が次のいずれかに該当するもの
（一）～（三）　（略）
（四）　七五ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、五・〇ギガヘルツを超えるもの
ヘ　最大出力周波数が一一〇ギガヘルツを超えるもの
十四　ネットワークアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの
イ　四三・五ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下のいずれかの動作周波数帯域において、出力が一〇〇ミリワット（二〇ディービーエム）を超えるもの
ロ　削除
ハ　五〇ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下の周波数帯域における非線形ベクトルの計測機能を有するもの（イに該当するものを除く。）
ニ　（略）
十五～十六の二　（略）
十六の三　極低温用の冷却装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ　零下二七三・〇五度以下の温度において、四八時間超にわたって、六〇〇マイクロワット以上の冷凍出力を供給する定格のもの
ロ　二段式のパルスチューブ冷凍機であって、温度を零下二六九・一五度未満に維持するものであり、かつ、零下二六八・九五度以下の温度において、一・五ワット以上の冷凍出力を供給する定格のもの
十七　半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置（ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。）若しくは試験装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品
イ　結晶のエピタキシャル成長装置であって、次のいずれかに該当するものを除く。
（一）　（略）
（二）　有機金属化学的気相成長反応炉であって、アルミニウム、ガリウム、インジウム、砒素、りん、アンチモン、酸素又は窒素のいずれか二以上の元素を有する化合物半導体をエピタキシャル成長させるもの
（三）　（略）
ロ～ホ　（略）
ヘ　リソグラフィ装置であって、次のいずれかに該当するもの
（一）　（略）
（二）　インプリントリソグラフィ装置であって、四五ナノメートル以下の線幅を実現することができるもの（テに該当するものを除く。）
（三）・（四）　（略）
ト　削除
チ　削除
リ　削除

ホ　デジタルベースバンド信号をベクトル変調する機能を有するもので、ベクトル変調帯域幅が次のいずれかに該当するもの
（一）～（三）　（略）
（四）　七五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、五・〇ギガヘルツを超えるもの
ヘ　最大出力周波数が九〇ギガヘルツを超えるもの
十四　ネットワークアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの
イ　四三・五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下のいずれかの動作周波数帯域において、出力が三一・六二ミリワット（一五ディービーエム）を超えるもの
ロ　九〇ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下のいずれかの動作周波数帯域において、出力が一ミリワット（〇ディービーエム）を超えるもの
ハ　五〇ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下の周波数帯域における非線形ベクトルの計測機能を有するもの（イ又はロに該当するものを除く。）
ニ　（略）
十五～十六の二　（略）
（新設）
十七　半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置（ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。）若しくは試験装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品（次号に該当するものを除く。）
イ　結晶のエピタキシャル成長装置であって、次のいずれかに該当するものを除く。
（一）　（略）
（二）　有機金属化学的気相成長反応炉であって、アルミニウム、ガリウム、インジウム、砒素、燐、アンチモン又は窒素のいずれか二以上の元素を有する化合物半導体をエピタキシャル成長させるもの
（三）　（略）
ロ～ホ　（略）
ヘ　リソグラフィ装置であって、次のいずれかに該当するもの
（一）　（略）
（二）　インプリントリソグラフィ装置であって、四五ナノメートル以下の線幅を実現することができるもの
（三）・（四）　（略）
ト　マスク又はレチクルであって、第一号から第八号の四までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの
チ　位相シフト膜を有する多層マスクであって、光源の波長が二四五ナノメートル未満のリソグラフィ装置に用いるために設計したもの（トに該当するもの及び第一号から第八号の四までのいずれにも該当しない記憶素子を製造するために設計したものを除く。）
リ　インプリントリソグラフィテンプレートであって、第一号から第八号の四までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの